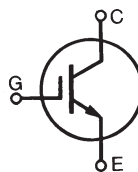


# High Voltage IGBT

**IXGH 32N170**  
**IXGT 32N170**

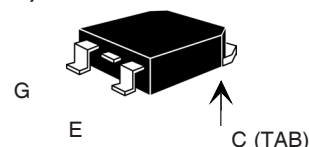
**V<sub>CES</sub> = 1700 V**  
**I<sub>C25</sub> = 75 A**  
**V<sub>CE(sat)</sub> = 3.3 V**  
**t<sub>fi(typ)</sub> = 250 ns**

## Preliminary Data Sheet

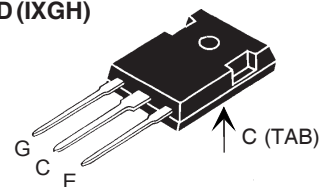


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V <sub>CES</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C to 150°C	1700	V
V <sub>CGR</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C to 150°C; R <sub>GE</sub> = 1 MΩ	1700	V
V <sub>GES</sub>	Continuous	±20	V
V <sub>GEM</sub>	Transient	±30	V
I <sub>C25</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	75	A
I <sub>C90</sub>	T <sub>C</sub> = 90°C	32	A
I <sub>CM</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C, 1 ms	200	A
<b>SSOA (RBSOA)</b>	V <sub>GE</sub> = 15 V, T <sub>VJ</sub> = 125°C, R <sub>G</sub> = 5 Ω Clamped inductive load	I <sub>CM</sub> = 90 @ 0.8 V <sub>CES</sub>	A
P <sub>C</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	350	W
T <sub>J</sub>		-55 ... +150	°C
T <sub>JM</sub>		150	°C
T <sub>stg</sub>		-55 ... +150	°C
Maximum Lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	°C
Maximum Tab temperature for soldering SMD devices for 10 s		260	°C
M <sub>d</sub>	Mounting torque (M3)	1.13/10Nm/lb.in.	
<b>Weight</b>		TO-247 AD	6 g
		TO-268	4 g

### TO-268 (IXGT)



### TO-247 AD (IXGH)



G = Gate, C = Collector,  
E = Emitter, TAB = Collector

### Features

- International standard packages  
JEDEC TO-268 and  
JEDEC TO-247 AD
- High current handling capability
- MOS Gate turn-on  
- drive simplicity
- Rugged NPT structure
- Molding epoxies meet UL 94 V-0  
flammability classification

### Applications

- Capacitor discharge & pulser circuits
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode  
power supplies

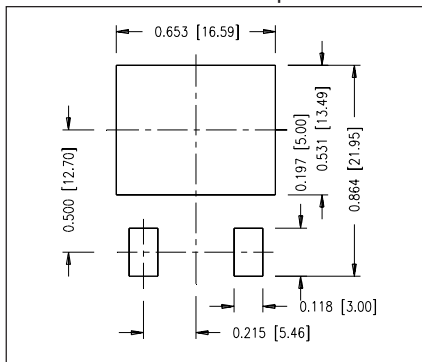
### Advantages

- High power density
- Suitable for surface mounting
- Easy to mount with 1 screw,  
(isolated mounting screw hole)

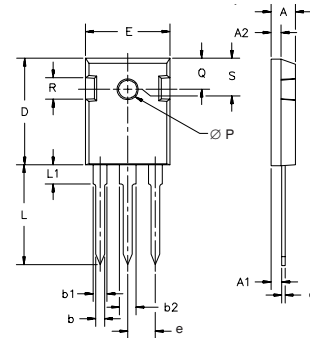
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T <sub>J</sub> = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
<b>BV<sub>CES</sub></b>	I <sub>C</sub> = 250 μA, V <sub>GE</sub> = 0 V	1700		V
<b>V<sub>GE(th)</sub></b>	I <sub>C</sub> = 250 μA, V <sub>CE</sub> = V <sub>GE</sub>	3.0		V
<b>I<sub>CES</sub></b>	V <sub>CE</sub> = 0.8 • V <sub>CES</sub>			50 μA
	V <sub>GE</sub> = 0 V			1 mA
<b>I<sub>GES</sub></b>	V <sub>CE</sub> = 0 V, V <sub>GE</sub> = ±20 V			±100 nA
<b>V<sub>CE(sat)</sub></b>	I <sub>C</sub> = I <sub>C90</sub> , V <sub>GE</sub> = 15 V	T <sub>J</sub> = 25°C	2.5	3.3 V
		T <sub>J</sub> = 125°C	3.0	V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$g_{fs}$	$I_C = I_{C90}$ ; $V_{CE} = 10\text{ V}$ , Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle $\leq 2\%$	22	30	S
$I_{C(ON)}$	$V_{GE} = 10\text{ V}$ , $V_{CE} = 10\text{ V}$		120	A
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$		3500	pF
$C_{oes}$			165	pF
$C_{res}$			40	pF
$Q_g$	$I_C = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$ , $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		155	nC
$Q_{ge}$			30	nC
$Q_{gc}$			51	nC
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.6 V_{CES}$ , $R_G = R_{off} = 2.7\ \Omega$		45	ns
$t_{ri}$			38	ns
$t_{d(off)}$			270	500 ns
$t_{fi}$			250	500 ns
$E_{off}$			11	20 mJ
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b> $I_C = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.6 V_{CES}$ , $R_G = R_{off} = 2.7\ \Omega$		48	ns
$t_{ri}$			42	ns
$E_{on}$			6.0	mJ
$t_{d(off)}$			360	ns
$t_{fi}$			560	ns
$E_{off}$		14	mJ	
$R_{thJC}$			0.35	KW
$R_{thCK}$	(TO-247)	0.25		KW

### Min Recommended Footprint

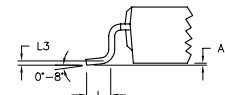
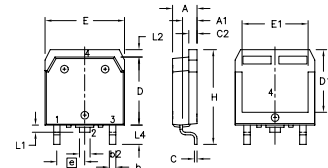


### TO-247 AD Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A <sub>1</sub>	2.2	2.54	.087	.102
A <sub>2</sub>	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b <sub>1</sub>	1.65	2.13	.065	.084
b <sub>2</sub>	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

### TO-268 Outline



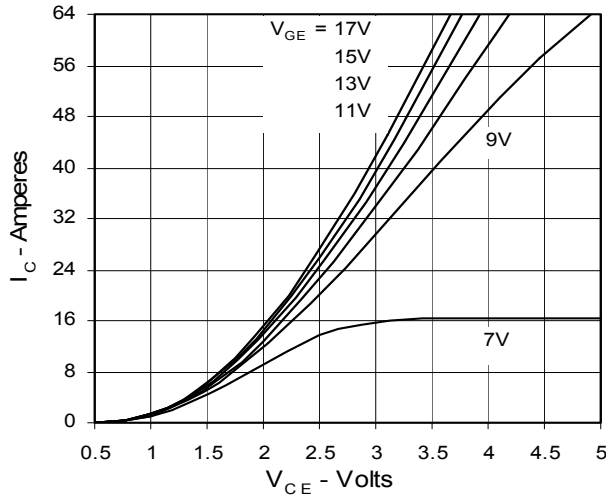
Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A <sub>1</sub>	2.7	2.9	.106	.114
A <sub>2</sub>	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b <sub>2</sub>	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E <sub>1</sub>	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45	BSC	.215	BSC
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L1	1.20	1.40	.047	.055
L2	1.00	1.15	.039	.045
L3		0.25		.010
L4	3.80	4.10	.150	.161

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

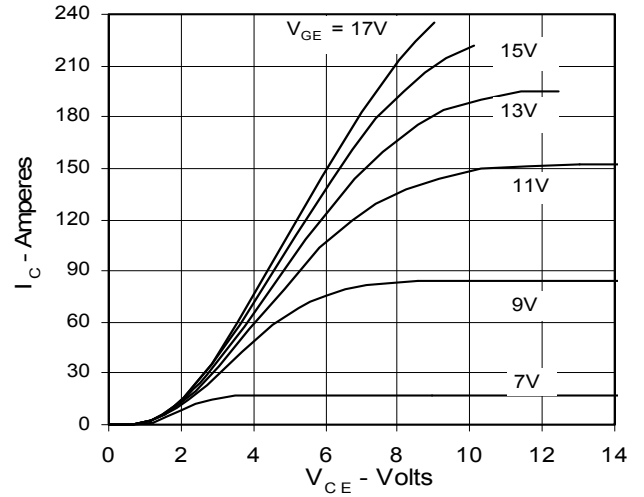
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1 6,259,123B1 6,306,728B1  
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025 6,404,065B1 6,162,665 6,534,343 6,583,505

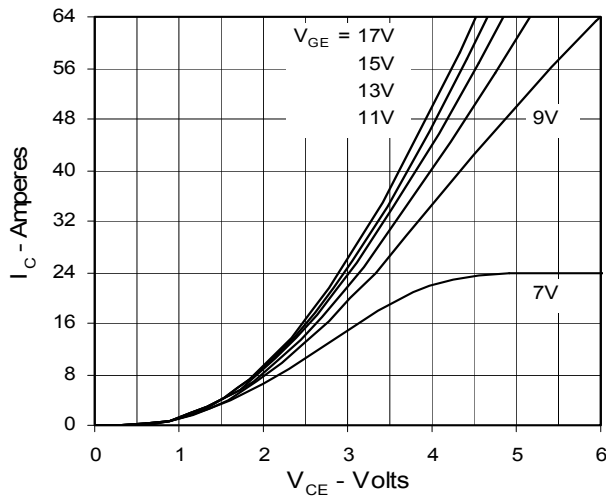
**Fig. 1. Output Characteristics @ 25 Deg. C**



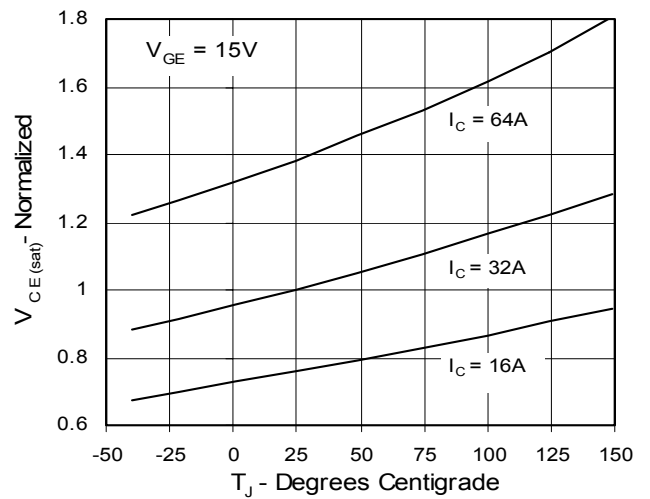
**Fig. 2. Extended Output Characteristics @ 25 deg. C**



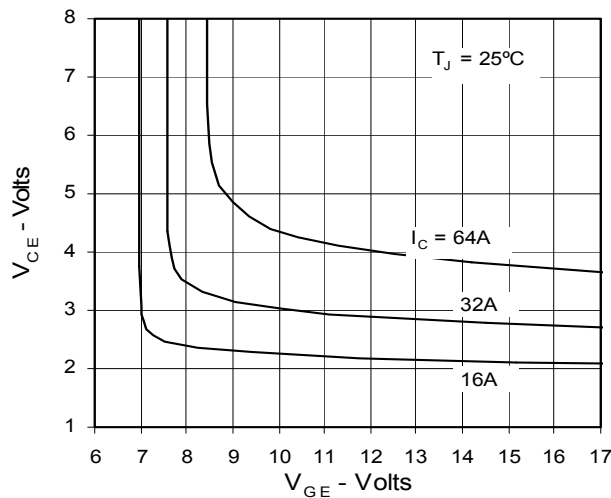
**Fig. 3. Output Characteristics @ 125 Deg. C**



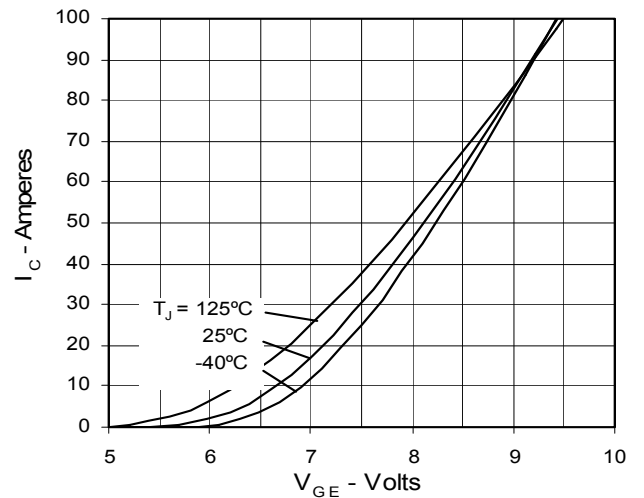
**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Temperature**



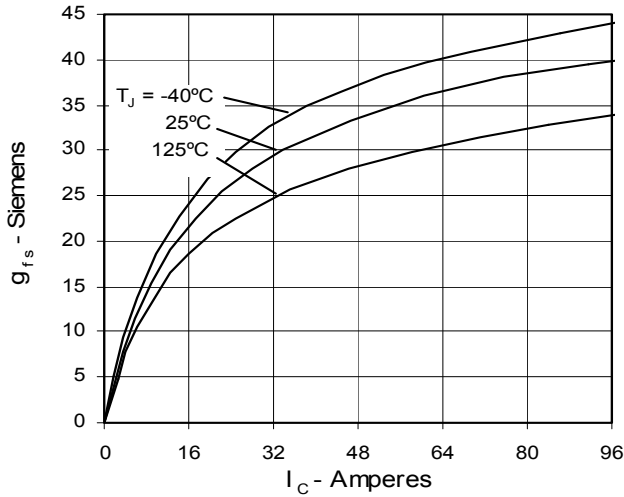
**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter voltage**



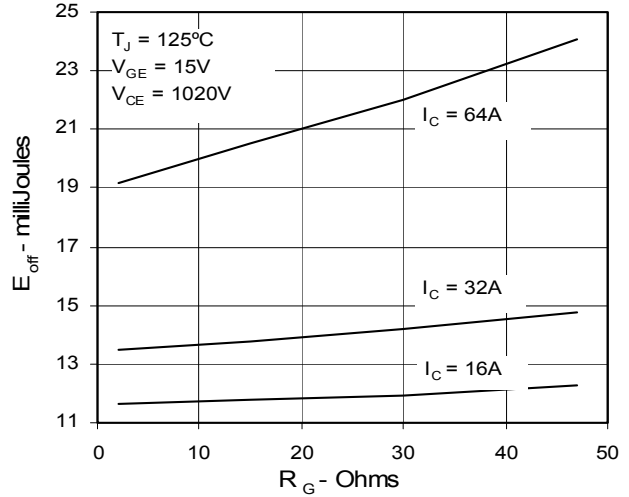
**Fig. 6. Input Admittance**



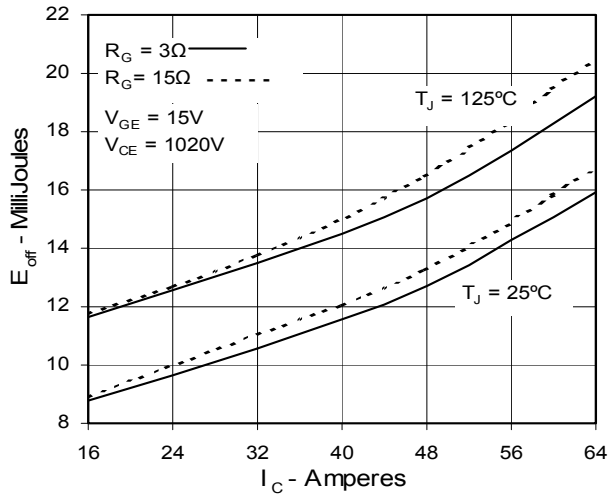
**Fig. 7. Transconductance**



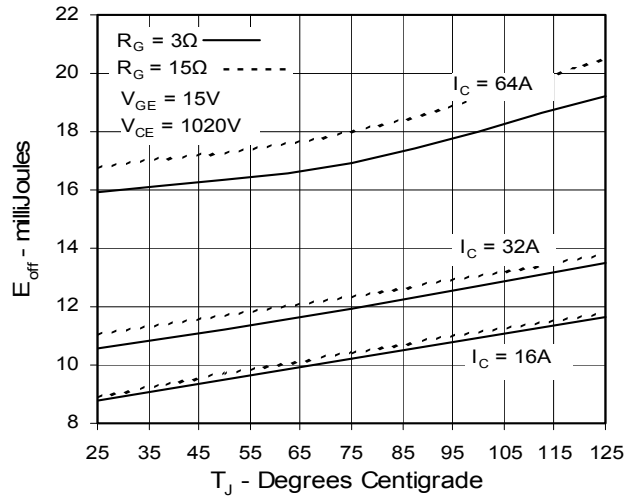
**Fig. 8. Dependence of  $E_{off}$  on  $R_G$**



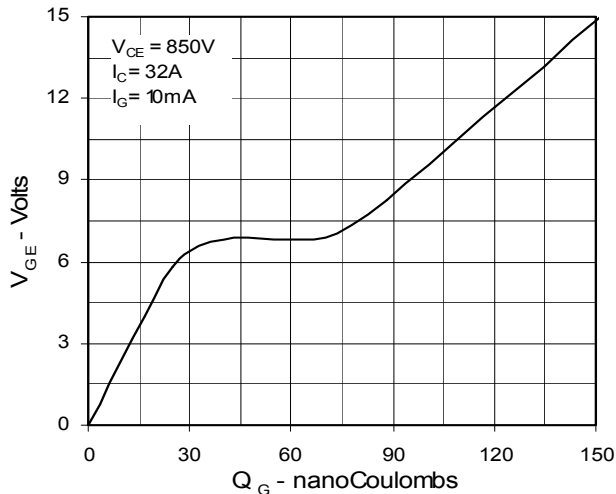
**Fig. 9. Dependence of  $E_{off}$  on  $I_C$**



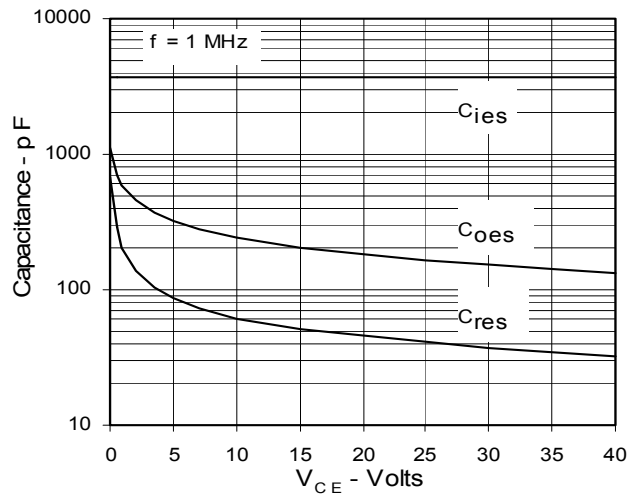
**Fig. 10. Dependence of  $E_{off}$  on Temperature**



**Fig. 11. Gate Charge**



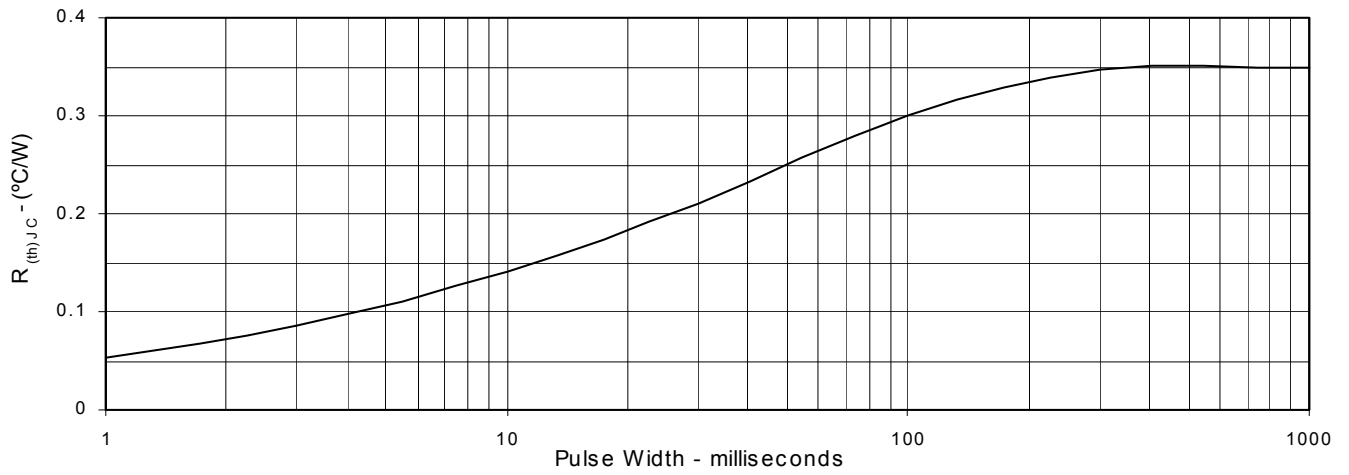
**Fig. 12. Capacitance**



IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1 6,259,123B1 6,306,728B1 4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025 6,404,065B1 6,162,665 6,534,343 6,583,505

Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331